

(19)
(12)

(KR)
(A)

(51) 。 Int. Cl.⁷
H05B 33/04

(11)
(43)

2003-0094917
2003 12 18

(21) 10-2002-0032266
(22) 2002 06 10

(71) 1355-26

(72) 305 104

4 24-36

(74)

:

(54)

(Shield Effect)가

가 /
.

1 , 1

2 , 2 Al ,

2c

, , , , ,

1 ,

2a 2c .

< >

20 : 21 :

22 : 1 23 :

24 : 25 :

26 : 2 27 :

/ 가 ,
(' EL ') , ,
가 ,
1 EL .
, EL (glass) (film) (11) (10) (12)
ITO(Indium Tin Oxide) (11) , (11)
(12) (12) (13) , (13) (1
4) (12) , (14) , (15) .
EL (14) 가 ,
,
, EL (16) SUS (Encapsulation)(16)
(16) (11) (sealant)(17)
~ , 가 가
가 , 가 가
(dark spot) (Shield effect)가 .

가 ,
/ .
1 ; 1
2 ; 2 Al
;
2 2
2 (Resin) , 가 2 가
(Pin Holeless)
.
.
2a , (20) 1 (22) (21) ,
(20)
, (21) 가 , , , , ,
(ITO), , , , ,
2
, (21) 100 ~ 10,000 , 10
0 ~ 2000 가 .
, 1 (22) (25) 1 (22) (24) , , ,
(23) (24)
, (24) 가 , , 2 ,
, , ,
100 , (24) 100 ~ 10,000 ,
~ 2000 가 .
, (24)
Deposition ; PECVD) (24) (Plasma Enhanced Chemical Vapor
(26) (2b).
, 2 (26) (Parylene) SiO, SiO₂, SiN_x, SiN_xO_y
0.1μm ~ 20μm .
(SiO₂) (SiN_x) (mono-layer) 0.2μm ~ 2.0μm
가 SiH₄, O₂ 2 (26) (SiO₂) 가 SiH₄, N
2, NH₃ ~ 2.0μm 500 0.2μm
, (24) 2 (26) , 2 (26) Al
(27) (2c), (27)
(27)

(27)
가 , 가 (pin hole)
/
, (24) 2 (26) (27) 2
가
, 3 (2 (26)) (27) 3 (27) 2 (26)
, (24) 2 (26) , 3 2 (26) (27)
(Pin holeless)

가 / 가

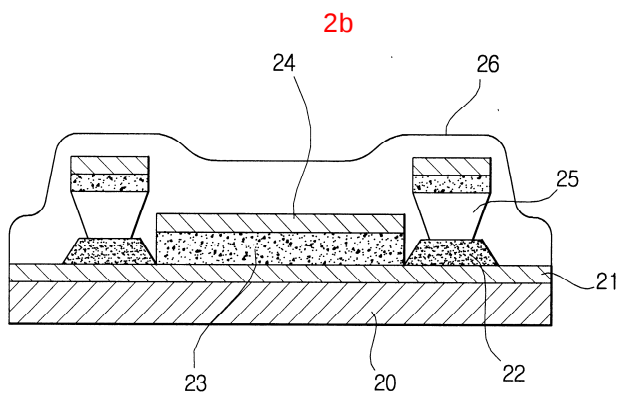
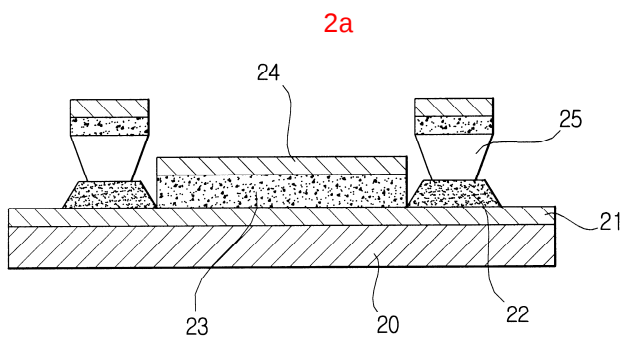
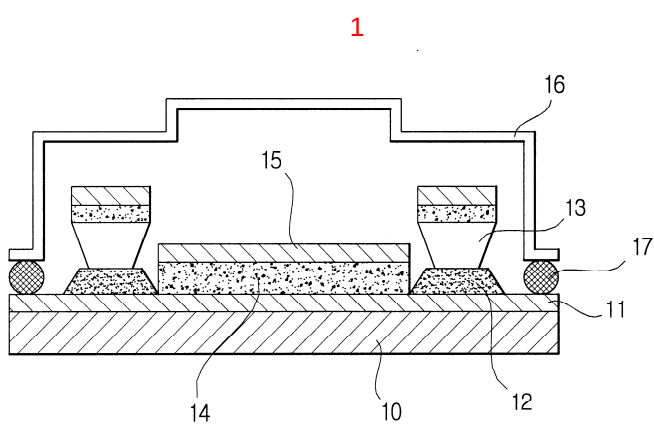
가 ,

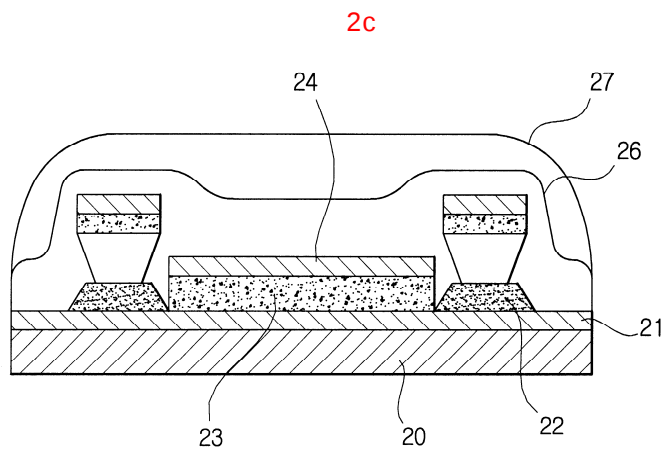
(57)

1.
(20) (21) 1 (22) 1 ;
1 (22) (25) (23) (24) 2
;
(24) 2 (26) 3 ;
2 (26) (27) 4 ;
(27) 5
.
2.
1 ,
3 , 4 , 5 2
.
3.
1 , 2 ;
.
4.

1 , ;
Al .

5.
1 5 , 3 4 ;
2 (Resin) 가 ,
4 ;





专利名称(译)	有机电致发光显示元件的键合方法		
公开(公告)号	KR1020030094917A	公开(公告)日	2003-12-18
申请号	KR1020020032266	申请日	2002-06-10
[标]申请(专利权)人(译)	ELIATECH		
申请(专利权)人(译)	电梯技术有限公司.		
当前申请(专利权)人(译)	电梯技术有限公司.		
[标]发明人	IM SEONGSIL 임성실 SON MINSOO 손민수		
发明人	임성실 손민수		
IPC分类号	H05B33/04 H01L51/52		
CPC分类号	H01L51/5237 H01L51/5253		
代理人(译)	CHO , TARM		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

通过在阴极电极的上部依次层叠绝缘层和金属层，并且在激光下对层叠的金属层进行热处理和再结晶，并且与形成的薄膜相比具有非常复杂的结构采用物理成型方法，在高温/高湿条件下产生足够的屏蔽效应，延长了器件发光的稳定性和使用寿命。为此，根据本发明，在其形成的介电层的第一顶部中的阴极电极隔板依次形成阳极电极和第一绝缘层以及有源层和阴极电极，第二绝缘层如硅在形成之后，在阴极电极的上部形成氧化膜，或者在基板的上部形成氮化硅膜。并且在介电层的第二顶部上形成类似Al膜的金属层，并且在激光下对形成的金属层进行热处理并使其再结晶。袋，绝缘层，金属层，激光，热处理，再结晶。

